

波兰 VIGO System 公司是生产红外探测器及配套偏置和前置放大电路的专业公司,该公司具有包括 MOCVD 和 MBE 的完整红外探测器生产线,从 MCT 和 III-V 族(InAs、InAsSb)材料晶体生成、半导体衬底片(Wafer)、探测器、偏置电路及前置放大器全部自主生产;探测器的波长响应范围包括短波、中波及长波,最远可到 16 微米;按制冷方式分产品又可分 2、3、4 级半导体制冷型和非制冷型两大类,共有数十种型号。



探测器主要性能参数—PC 光导、PCI 光导光浸没型)

型号序列	优化波长 λ opt	4 μ m	5 μ m	6 µ m	9 μ m	10 . 6 μ m	12 µ m	13 µ m	14 µ m	技术特点
	主要参数									
PC-λopt	D* cmHz ^{1/2} /W	$\geq 2.0 \times 10^9$	$\geq 1.0 \times 10^9$	\geqslant 3.0 × 10 ⁸	$\geq 2.0 \times 10^7$	\geqslant 9.0 × 10 ⁶				无需制冷
非制冷	Ri•L A•mm/W	≥0.1	≥0.07	≥0.02	≥0.003	≥0.001				
	时间常数 T ns	≤12000	≤5000	≤500	≤10	€3				适用于交流
DG OWD 3	D* cmHz ^{1/2} /W	$\geq 2.0 \times 10^{10}$	$\geq 1.0 \times 10^{10}$	\geqslant 3.0 × 10 ⁹	$\geq 4.5 \times 10^8$	$\geq 1.4 \times 10^8$	\geqslant 4.5 × 10 ⁷	$\geq 2.3 \times 10^7$		
PC-2TE-λopt	Ri•L A•mm/W	≥0.65	≥0.5	≥0.18	≥0.025	≥0.01	≥0.005	≥0.002		
2 级制冷	时间常数 T ns	≤30000	≤20000	≤4000	≤40	≤10	€3	€2		
DG OWD 1	D* cmHz ^{1/2} /W				$\geq 1.0 \times 10^9$	$\geq 2.5 \times 10^8$	$\geq 9.0 \times 10^7$	$\geq 6.0 \times 10^7$		小型制冷 光导型
PC-3TE-λopt	Ri•L A•mm/W				≥0.075	≥0.02	≥0.01	≥0.007		大 光敏面积 适用于交流 超长波响应
3 级制冷	时间常数 τ ns				≤60	€20	€5	≤4		
DC 4770 3	D* cmHz ^{1/2} /W				$\geq 2.0 \times 10^9$	\geqslant 3.5 × 10 ⁸	$\geq 2.0 \times 10^8$	$\geq 1.0 \times 10^8$	$\geq 6.0 \times 10^7$	
PC-4TE- λ opt	Ri•L A•mm/W				≥0.075	≥0.02	≥0.01	≥0.007	≥0.007	
4 级制冷	时间常数 T ns				≤80	≤30	€7	€6	€5	
DOT 1	D* cmHz ^{1/2} /W	$\geq 6.0 \times 10^9$	$\geq 4.0 \times 10^9$	$\geq 1.0 \times 10^8$	$\geq 1.0 \times 10^{8}$	$\geq 8.0 \times 10^7$				无需制冷
PCI-λopt	Ri•L A•mm/W	≥0.6	≥0.5	≥0.2	≥0.02	≥0.008				光导型 大光敏面积
非制冷	时间常数 T ns	≤12000	≤5000	≤500	≤10	€3				适用于交流
par amp 1	D* cmHz ^{1/2} /W	\geq 4.0 × 10 ¹⁰	\geq 2.0 × 10 ¹⁰	$\geq 1.0 \times 10^{10}$	\geq 4.0×10 ⁹	$\geq 1.0 \times 10^9$	\geq 4.5 × 10 ⁸	$\geq 2.3 \times 10^8$		小型制冷
PCI-2TE- λ opt	Ri•L A•mm/W	≥4.0	≥3.0	≥1.5	≥0.225	≥0.1	≥0.05	≥0.03		光导型 光浸没
2 级制冷	时间常数 T ns	€30000	≤20000	≤4000	€40	€10	€3	€2		



北京北埃特光电子技术有限责任公司 BIT Photoelectronic Co., Ltd.

地址: 北京市海淀区中关村南大街 9 号理工科技大厦 7015 室(100081) **网址:** www. bitpe. com



DCI OTE 1 and	D* cmHz ^{1/2} /W		\geq 6.2×10 ⁹	$\geq 2.5 \times 10^9$	\geqslant 9.0 × 10 ⁸	\geqslant 4.5×10 ⁸		适用于交流
PCI-3TE-λopt 3 级制冷	Ri•L A•mm/W		≥0.7	≥0.17	≥0.07	≥0.03		超长波响应
2 欲响存	时间常数 T ns		€60	€20	€5	€4		
DCI ATE \ amb	D* cmHz ^{1/2} /W		$\geq 1.0 \times 10^{10}$	$\geq 3.0 \times 10^9$	$\geq 2.0 \times 10^9$	$\geq 1.0 \times 10^9$	$\geqslant 3.0 \times 10^8$	
PCI-4TE-λopt 4 级制冷	Ri•L A•mm/W		≥0.9	≥0.2	≥0.09	≥0.05	≥0.03	
4 级明行	时间常数 T ns		€80	€30	€7	≤6	€5	

注: λ opt 优化波长为工艺参数,比峰值波长略长; PC 及 PCI 型探测器只适用于探测交流信号; 光敏面积最大可到 4x4, 特殊要求可以更大。

探测器主要性能参数—PV 光伏、PVI 光伏光浸没型探测器

型号序列	优化波长 λ opt 主要参数	3 µ m	3.4 µ m	4 μ m	5 μ m	6 µ m	8 μ m	10.6 µ m		技术特点
DV 3	D* cmHz ^{1/2} /W	$\geq 6.5 \times 10^9$	$\geq 5.0 \times 10^9$	\geqslant 3.0 × 10 ⁹	$\geq 1.0 \times 10^9$	\geq 5.0 × 10 ⁸				无需制冷
PV−λopt ∃bebly&	Ri A/W	≥0.5	≥0.8	≥1	≥1	≥1				光伏型
非制冷	时间常数 T ns	€350	≤260	≤150	≤120	€80				交/直流可用
DV OTE \+	D* cmHz ^{1/2} /W	\geqslant 7.0 × 10 ¹⁰	\geq 4.0×10 ¹⁰	\geqslant 3.0 × 10 ¹⁰	$\geq 9.0 \times 10^9$	$\geq 2.0 \times 10^9$	$\geq 2.0 \times 10^8$	$\geq 1.0 \times 10^8$		
PV-2TE-λ opt 2 级制冷	Ri A/W	≥0.5	≥0.8	≥1.0	≥1.3	≥1.5	≥0.8	≥0.4		小型制冷
2 级闸符	时间常数 T ns	≤280	≤200	≤100	€80	€50	≤30/45	≤10		
DV 2TE \+	D* cmHz ^{1/2} /W	$\geq 1.0 \times 10^{11}$	\geqslant 7.0 × 10 ¹⁰	\geqslant 4.0×10 ¹⁰	$\geq 1.0 \times 10^{10}$	$\geq 4.0 \times 10^9$	$\geqslant 3.0 \times 10^8$	$\geq 1.5 \times 10^8$		
PV-3TE-λopt 3 级制冷	Ri A/W	≥0.5	≥0.8	≥1.0	≥1.3	≥1.5	≥1.0	≥0.7		光伏型 高灵敏度
3 级明行	时间常数 T ns	≤280	€200	€100	€80	€50	€30/45	€10		交/直流可用
PV-4TE-λopt	D* cmHz ^{1/2} /W	$\geq 1.5 \times 10^{11}$	$\geq 1.0 \times 10^{11}$	\geq 6.0×10 ¹⁰	$\geq 1.5 \times 10^{10}$	\geqslant 5. 0×10 ⁹	\geqslant 4.0×10 ⁸	$\geq 2.0 \times 10^8$		
•	Ri A/W	≥0.5	≥0.8	≥1.0	≥1.3	≥1.5	≥1.5	≥0.7/0.5		
4 级制冷	时间常数 T ns	≤280	€200	€100	€80	€50	€30/45	€10/25		
DVI -) ont	D* cmHz ^{1/2} /W	\geq 5.0 × 10 ¹⁰	\geq 4.5 × 10 ¹⁰	\geq 2.0 × 10 ¹⁰	$\geq 9.0 \times 10^9$	$\geq 4.0 \times 10^9$				无需制冷
PVI-λopt 非制冷	Ri A/W	≥0.5	≥0.8	≥1	≥1	≥1				光伏型
⊣⊢.և1144,	时间常数 T ns	€350	€260	≤150	€120	€80				交/直流可用



北京北埃特光电子技术有限责任公司 BIT Photoelectronic Co., Ltd.

地址: 北京市海淀区中关村南大街 9 号理工科技大厦 7015 室(100081) 网址: www.bitpe.com



DUI OTE 1	D* cmHz ^{1/2} /W	\geqslant 5.5 × 10 ¹¹	\geqslant 3.0 × 10 ¹¹	$\geq 2.0 \times 10^{11}$	\geq 6.0 × 10 ¹⁰	\geq 2.0 × 10 ¹⁰	$\geq 2.0 \times 10^9$	$\geq 1.0 \times 10^9$	
PVI-2TE-λopt 2 级制冷	Ri A/W	≥0.5	≥0.8	≥1.0	≥1.3	≥1.5	≥0.8	≥0.4	
2 级闸行	时间常数 T ns	≤280	≤200	≤100	€80	≤50	≤30/45	≤10	
DUI OTE 1	D* cmHz ^{1/2} /W	\geqslant 7.0×10 ¹¹	\geqslant 5.0 \times 10 ¹¹	\geqslant 3.0 \times 10 ¹¹	\geqslant 8.0×10 ¹⁰	\geqslant 3.0 \times 10 ¹⁰	\geqslant 3.0 \times 10 ⁹	≥1.5×10 ⁹	小型制冷
PVI-3TE-λopt 3 级制冷	Ri A/W	≥0.5	≥0.8	≥1.0	≥1.3	≥1.5	≥1.0	≥0.7	光伏型 高灵敏度
3 级闸代	时间常数 T ns	≤280	≤200	≤100	≤80	≤50	≤30/45	≤10	交/直流可用
DVI ATE 3	D* cmHz ^{1/2} /W	$\geq 8.0 \times 10^{11}$	\geqslant 7.0×10 ¹¹	\geqslant 4.0×10 ¹¹	$\geq 1.0 \times 10^{11}$	\geqslant 4. 0×10 ¹⁰	\geq 4.0 × 10 ⁹	$\geq 2.0 \times 10^9$	
PVI-4TE-λopt 4 级制冷	Ri A/W	≥0.5	≥0.8	≥1.0	≥1.3	≥1.5	≥1.5	≥0.7/0.5	
4 级制代	时间常数 T ns	≤280	≤200	≤100	€80	€50	≤30/45	≤10/25	
	特定吸收波长	2.9 µ m	3.3 µ m	3.3 µ m	4.5 μ m	6.2, 6.3 µ m		9.4 μ m	
环保应用	适合气体	H ₂ O	甲烷 CH4	甲烷 CH4	N ₂ O、CO	NO ₂ 、H ₂ O		CO_2	

注: PV 及 PVI 型探测器可探测交/直流信号; PV 光敏面积最大 0.1x0.1、PVI 为 1x1。

探测器主要性能参数--PVM 光伏磁、PVMI 光伏磁光浸没探测器

型号序列	优化波长 Lopt 主要参数	4 μ m	5 μ m	6 µ m	8 μ m	10.6 µ m	12 µ m	13 µ m	14 µ m	技术特点
DVM \ and	D* cmHz ^{1/2} /W				$\geq 6.0 \times 10^7$	$\geq 1.0 \times 10^7$. 无需制冷
PVM- λ opt 非制冷	Ri•L A•mm/W				≥0.008	≥0.002				大光敏面积
∃E±±14.44.	时间常数 T ns				€4	≤1.5				高速响应
DVM OTE 1	D* cmHz ^{1/2} /W				$\geqslant 3.0 \times 10^8$	$\geq 1.0 \times 10^8$				
PVM-2TE-λopt 2 级制冷	Ri•L A•mm/W				≥0.015	≥0.06				
2级则行	时间常数 T ns				€4	€3				小型制冷 大光敏面积
+	D* cmHz ^{1/2} /W				$\geqslant 3.0 \times 10^8$	$\geq 1.0 \times 10^8$				高速响应
非制冷	Ri•L A•mm/W				≥0.04	≥0.01				
コト山14名。	时间常数 T ns				≤4	≤1.5				



北京北埃特光电子技术有限责任公司 BIT Photoelectronic Co., Ltd.

地址: 北京市海淀区中关村南大街 9 号理工科技大厦 7015 室(100081) 网址: www.bitpe.com



DIALT OFF 3 and	D* cmHz ^{1/2} /W	$\geq 2.0 \times 10^9$	$\geq 1.0 \times 10^9$		
PVMI-2TE-λopt 2 级制冷	Ri•L A•mm/W	≥0.15	≥0.10		
2 级闸代	时间常数 T ns	≤4	€3		
DVMT 2TE \	D* cmHz ^{1/2} /W	$\geqslant 3.0 \times 10^9$	$\geq 1.5 \times 10^9$		
PVMI-3TE-λopt 3 级制冷	Ri•L A•mm/W	≥0.075	≥0.002		
3 级闸代	时间常数 T ns	≤60	≤1.2		
DVMT ATE 1	D* cmHz ^{1/2} /W	$\geq 6.0 \times 10^9$	$\geq 2.0 \times 10^9$		
PVMI-4TE-λopt 4 级制冷	Ri•L A•mm/W	≥0.20	≥0.15		
4 纵削行	时间常数 T ns	≤4	€3		

探测器主要性能参数--PEM、PVMI 光电磁效应探测器

型号序列	优化波长 Lopt 主要参数	4 μ m	5 μ m	6 µ m	9 μ m	10.6 µ m	12 µ m	13 µ m	14 µ m	技术特点
DEW 10 C	D* cmHz ^{1/2} /W					$\geq 1.0 \times 10^7$				工作中心人
PEM-10.6 非制冷	Ri•L A•mm/W					≥0.002				无需制冷 高速响应
11年前14年	时间常数 T ns					≤1.2				14/45.13/27
DENT 10 C	D* cmHz ^{1/2} /W					$\geq 1.0 \times 10^{8}$				无需制冷
PEMI-10.6 非制冷	Ri•L A•mm/W					≥0.01				浸没光增强
HE 前代	时间常数 T ns					≤1.2				高速响应

探测器主要性能参数--PVQ、PCQ、PVMQ 四象限探测器

型号序列	优化波长 Lopt 主要参数	4 μ m	5 μ m	6 μ m	9 μ m	10.6 µ m	12 µ m	13 µ m	14 µ m	技术特点
DVO E	D* cmHz ^{1/2} /W		$\geq 1.0 \times 10^9$							四象限
PVQ-5 非制冷/四象限	Ri A/W		≥1.0							高灵敏度
当下明14人员家版	时间常数 T ns		≤120							无需制冷



北京北埃特光电子技术有限责任公司 BIT Photoelectronic Co., Ltd.

地址: 北京市海淀区中关村南大街 9 号理工科技大厦 7015 室(100081) 网址: www.bitpe.com



DCO 10 6	D* cmHz ^{1/2} /W		\geqslant 9.0 × 10 ⁶		四象限
PCQ-10.6 非制冷/四象限	Ri•L A•mm/W		≥0.001		大光敏面积 高速响应
15的代/四家院	时间常数 T ns		€5		高速响应
DVWO 10 6	D* cmHz ^{1/2} /W		$\geq 1.0 \times 10^7$		四象限
PVMQ-10.6 非制冷/四象限	Ri•L A•mm/W		≥0.002		大光敏面
15的代/四家院	时间常数 T ns		≤1.5		高速响应

探测器主要性能参数-6 (PVA、PVAI、PVA-2TE、PVAI-2TE InAs、InAsSb (III-V 族)

型号序列	峰值波长 λ peak 主要参数	3 µ m	3. 4 µ m	4 μ m	5 μ m	6 μ m	8 µ m	10.6 µ m	技术特点
	D* cmHz ^{1/2} /W	$\geq 5.0 \times 10^9$			$\geq 5.0 \times 10^8$				
PVA-λ peak	Ri A/W	≥1.3			≥1.3				
非制冷	时间常数 T ns	€20			≤60				
	波长响应范围	2.15∼3.5 µ m			2.3~5.5 μ m				
	D* cmHz ^{1/2} /W	\geqslant 5.0×10 ¹⁰			\geqslant 4.0×10 ⁹				
PVA-2TE- λ peak	Ri A/W	≥1.3			≥1.5				
2级制冷	时间常数 T ns	≤15			€20				
	波长响应范围	2.1~3.4 μ m			2.4~5.5 μ m				符合 RoHS
	D* cmHz ^{1/2} /W	\geqslant 5.0×10 ¹⁰			\geqslant 5.0 \times 10 ⁹				环保产品
PVIA-λ peak	Ri A/W	≥1.3			≥1.3				
非制冷	时间常数 T ns	€20			≤15				
	波长响应范围	2.15∼3.5 µ m			2.3~5.5 μ m				
	D* cmHz ^{1/2} /W	$\geq 5.0 \times 10^{11}$			\geqslant 4.0×10 ¹⁰			$\geqslant 3.0 \times 10^9$	
PVIA-2TE-λ peak	Ri A/W	≥1.3			≥1.5			TBD	
2级制冷	时间常数 T ns	≤15			€5			TBD	
	波长响应范围	2.1~3.4 μ m			2.4~5.5 μ m			1.7∼11.5 µ m	



北京北埃特光电子技术有限责任公司 BIT Photoelectronic Co., Ltd.

地址: 北京市海淀区中关村南大街 9 号理工科技大厦 7015 室(100081) 网址: www.bitpe.com



波兰 VIGO System 除了生产分立的探测器器件和与探测器完全配套的前置放大器及制冷控制电路外,还生产超高速探测装置等一系列**集成一体化高性能模块**,方便插电即可用,这些集成一体探测器装置再购买时就可以确定整个装置的探测率、响应率以及信号带宽,可根据不同的用途选择对应的型号。



集成探测装置主要性能参数

型号	产品特点	响应波长范围	峰值波长	峰值探测率	峰值响应率	带宽	直流监测
UHSM-10.6	一体、超高速	3∼12 µ m	$8.0\pm1.0~\mu$ m	4.5x10 ⁸ cm·Hz _{1/2} /W	$4.5x10^3 \text{ V/W}$	300∼1GHz	DC~260Hz
UHSM-I-10.6	一体、高速、高灵敏	3∼12 µ m	$8.5 \pm 0.5 \; \mu \; m$	1.5x10 ⁹ cm·Hz _{1/2} /W	$1.0x10^3 V/W$	300~700MHz	DC~260Hz
microM-10.6	超小型、一体	$2\sim$ 12 μ m	$8.0\pm1.5~\mu$ m	$1.5 \mathrm{x} 10^7 \mathrm{cm} \cdot \mathrm{Hz}_{1/2} / \mathrm{W}$	$1.2x10^2 \text{ V/W}$	DC~10MHz	DC~10MHz
UM-I-6	一体、中波探测	3.0∼6.7 µ m	$5.2\pm0.5~\mu$ m	2.3x10 ¹⁰ cm·Hz _{1/2} /W	$6.5 x 10^4 \text{ V/W}$	DC~1MHz	DC~150kHz
UM-10.6	一体、长波探测	2∼12 µ m	$9.3\pm2.0~\mu$ m	$5.0 x 10^7 \text{cm} \cdot \text{Hz}_{1/2} / \text{W}$	$1.6 x 10^2 \text{ V/W}$	DC~70MHz	DC~150kHz
UM-I-10.6	一体、高灵敏、长波探测	$2\sim$ 12 μ m	$8.5 \pm 1.5 \; \mu \; m$	5.5x10 ⁸ cm·Hz _{1/2} /W	$9.7x10^2 \text{ V/W}$	DC~100MHz	DC~150kHz
LabM-I-6	实验室中波探测	3.0∼7.5 µ m	5.5±0.5 μ m	$8.1 \mathrm{x} 10^9 \mathrm{cm} \cdot \mathrm{Hz}_{1/2} / \mathrm{W}$	$2.3x10^4 \text{ V/W}$	10∼200MHz	无
LabM-I-10.6	实验室长波探测	2∼12 µ m	9.5±0.5 μ m	$7.2x10^{8}\text{cm}\cdot\text{Hz}_{1/2}/\text{W}$	$2.4x10^3 \text{ V/W}$	DC~100MHz	无

前置放大器种类及主要性能参数

型号	产品特点	低频截止频率 f _L	高频截止频率 f _H	冷却方法
$MIP-f_L-f_H$	标准	DC、10、100、1k、10k	100k、1M、10M、100M、250M	PTCC
PIP-UC-LS	增益/带宽可调	DC/10Hz (UC) 用户端可调	150k/1.5M/20M (LS) 用户端可调	PTCC
PIP-UC-HS	增益/带宽可调	DC/10Hz 用户端可调	1.5M/15M/200M (HS) 用户端可调	PTCC
$FIP-f_L-f_H-D(ND)$	超高速、可带直流监控 D	1k、10k	1G	PTCC
SIP-f _L -f _H - TO8-G(NG)	小型、制冷、增益可调 G	DC、10、100、1k、10k	100k、1M、10M、100M、250M	外加热沉
SIP-f _L -f _H - TO39-G(NG)	小型、非制冷、增益可调 G	DC、10、100、1k、10k	100k、1M、10M、100M、250M	无

制冷控制器种类及主要技术特点

型号	PTCC-01-BAS	PTCC-01-ADV	PTCC-01-OEM
特点	基本型 可通过 USB 连接电脑调整制冷温度	可脱机或电脑调整制冷温度、实时屏显温度	无外壳,适用于 OEM



北京北埃特光电子技术有限责任公司 BIT Photoelectronic Co., Ltd.

地址: 北京市海淀区中关村南大街 9 号理工科技大厦 7015 室(100081) 网址: www.bitpe.com